

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

N.º 3597

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

Consultas de los clientes

Consultas de los medios

Semiconductor & Device Marketing Dept.A y Dept.B
Mitsubishi Electric Corporation

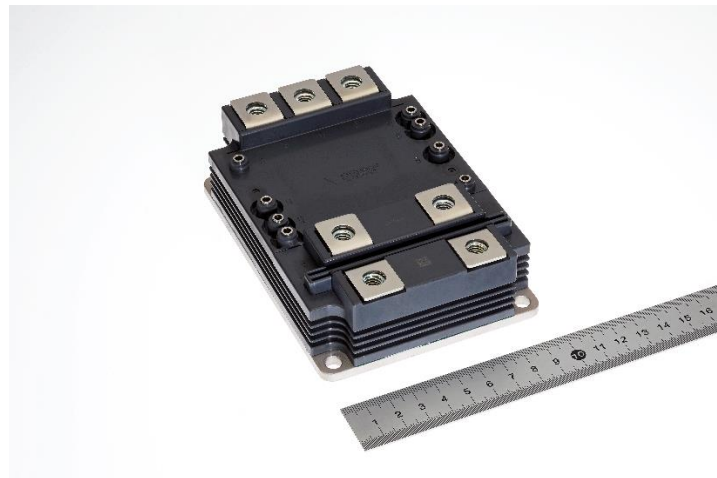
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
www.MitsubishiElectric.com/news/

Mitsubishi Electric enviará muestras del módulo MOSFET de SiC integrado en SBD

Para una mayor potencia y eficiencia de los sistemas de inversor que se utilizan en sistemas de energía eléctrica, ferroviarios y muchos más



Módulo 3,3 kV MOSFET de SiC integrado en SBD

TOKIO, 8 de mayo de 2023 – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishi-electric.com) (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a enviar muestras de un nuevo módulo de transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) integrado en carburo de silicio (SiC) con diodo de barrera Schottky (SBD), una tensión soportada dual de 3,3 kV y una rigidez dieléctrica de 6,0 kVrms, el 31 de mayo. Se espera que el nuevo módulo ofrezca una mayor potencia, eficiencia y fiabilidad en sistemas inversores para grandes equipos industriales, como sistemas de energía eléctrica y ferroviarios. Se exhibirá en las principales ferias comerciales, incluida la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2023 en Nuremberg (Alemania), del 9 al 11 de mayo.

Mitsubishi Electric ya ha lanzado cuatro módulos SiC completos y dos módulos LV100 de tipo doble de alta tensión de 3,3 kV. Para contribuir aún más a la alta potencia de salida, la eficiencia y la fiabilidad de los inversores para grandes equipos industriales, la empresa comenzará a suministrar muestras de su nuevo módulo, que reduce la pérdida de conmutación como un MOSFET de SiC con un SBD integrado y una estructura de paquete optimizada.

Características del producto

1) *El MOSFET de SiC integrado en SBD reduce la pérdida de potencia y contribuye a la potencia de salida, la eficiencia y la fiabilidad del inversor.*

- El MOSFET de SiC integrado en SBD y la estructura de paquete optimizada reducen la pérdida de conmutación en un 91 % en comparación con el módulo de potencia Si existente de la empresa* y en un 66 % en comparación con el módulo de potencia SiC existente**, lo que reduce la pérdida de potencia del inversor y contribuye a una mayor potencia de salida y eficiencia.
- El MOSFET de SiC integrado en SBD y la capacidad de corriente optimizada mejoran la fiabilidad del inversor.

2) *Diseño de terminal optimizado adecuado para diversas configuraciones y capacidades de inversor*

- El diseño optimizado de los terminales permite la conexión en paralelo y admite varias configuraciones y capacidades de inversor en función del número de conexiones en paralelo.
- La estructura del paquete, junto con los terminales principales de CC y CA en polos opuestos, ayuda a simplificar el diseño del circuito.

Especificaciones principales

Tipo	FMF800DC-66BEW
Tensión nominal	3,3 kV
Corriente nominal	800 A
Tensión de aislamiento	6,0 kVrms
Conexión	2 en 1
Dimensiones (An.×Pr.×Al.)	100 × 140 × 40 mm
Envíos de muestras	31 de mayo de 2023

Este producto se incluye en el número 2 (41)3 del cuadro 1 adjunto del Decreto sobre control del comercio de exportación.

Los semiconductores de potencia se utilizan cada vez más para convertir la energía eléctrica de forma eficiente con el fin de reducir la huella de carbono de la sociedad a nivel mundial. Esto ocurre especialmente en la industria pesada, donde dichos dispositivos se utilizan en equipos de conversión de potencia, como inversores de sistemas de tracción ferroviaria y para la transmisión de potencia de CC. Las expectativas son particularmente altas para los semiconductores de potencia SiC debido a su capacidad para reducir significativamente la pérdida de potencia. Además, los módulos semiconductores de potencia se utilizan en dispositivos de conversión de potencia para grandes equipos industriales. La demanda de semiconductores de potencia de alta potencia y alta eficiencia se está expandiendo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la conversión de potencia.

Sitio web

<https://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/>

###

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, la energía, el transporte y los equipos de construcción. A través del espíritu "Changes for the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró unos ingresos por valor de 5003,6 mil millones de yenes (unos 37,3 mil millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2023. Si desea obtener más información, visite www.MitsubishiElectric.com

*Las cantidades en dólares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de ¥134 = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo de 2023

* Módulo de potencia Si 3,3 kV/600 A (CM600DA-66X)

** Módulo de potencia Full-SiC 3,3 kV/750 A (FMF750DC-66 A)